

## 2SD636, 2SD637

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形

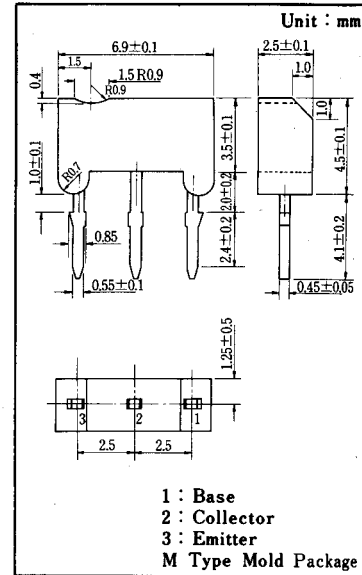
低電力一般増幅用

## ■ 特長

- 直流電流増幅率  $h_{FE}$  が高い。
- コレクタ・エミッタ飽和電圧  $V_{CE(sat)}$  が低い。
- M型パッケージで自動挿入、手挿入が容易、P板に自立固定できる。

■ 絶対最大定格 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	2SD636	30	V
	2SD637	60	
コレクタ・エミッタ電圧	2SD636	25	V
	2SD637	50	
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	7	V
せん頭コレクタ電流	$I_{CP}$	200	mA
コレクタ電流	$I_C$	100	mA
コレクタ損失	$P_C$	400	mW
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55~+150	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0$			1	$\mu\text{A}$
	$I_{CEO}$	$V_{CE}=20\text{V}, I_B=0$			1	
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	30			V
			60			
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	$I_C=2\text{mA}, I_B=0$	25			V
			50			
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$	7			V
直流電流増幅率	$h_{FE}^*$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=2\text{mA}$	160		460	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}$		0.3	0.5	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=-2\text{mA}, f=200\text{MHz}$		150		MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$		3.5		pF

\*  $h_{FE}$  ランク分類

ランク	Q	R	S
$h_{FE}$	160~260	210~340	290~460